

The Data Book Project

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

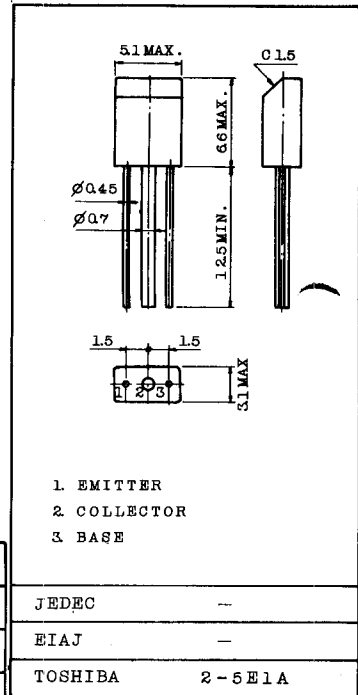
Scroll down to see the scanned document.

- 励振段増幅用
- 電圧増幅用
- Driver Stage Amplifier Applications
- Voltage Amplifier Applications
- ・ 高耐圧です； $V_{CEO} \geq 50V$
- ・ 許容コレクタ損失が大きい； $P_C = 600mW$ ($T_a = 25^\circ C$)
- ・ 2SA661とコンプリメンタリになり，コンプリメンタリ出力回路の励振用として最適です。
- ・ Complementary to 2SA661

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	200	mA
エミッタ電流	I_E	-200	mA
コレクタ損失	P_C	600	mW
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

Unit in mm



アクセサリはRH-16を適用
RADIATOR HOLDER RH-16

※ PCT技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

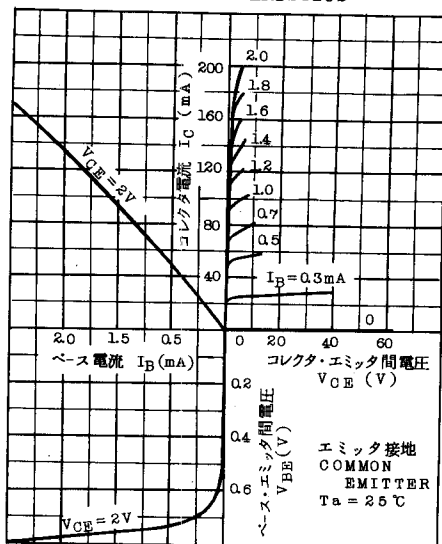
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$	—	—	100	nA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$	—	—	100	nA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=0$	50	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=0.1\text{mA}, I_C=0$	5	—	—	V
直流電圧増幅率	(Note) $h_{FE(1)}$	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=50\text{mA}$	40	100	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=200\text{mA}$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$	—	—	0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=200\text{mA}$	—	—	1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_E=-10\text{mA}$	70	120	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	9	—	pF

Note: $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し現品表示してあります。

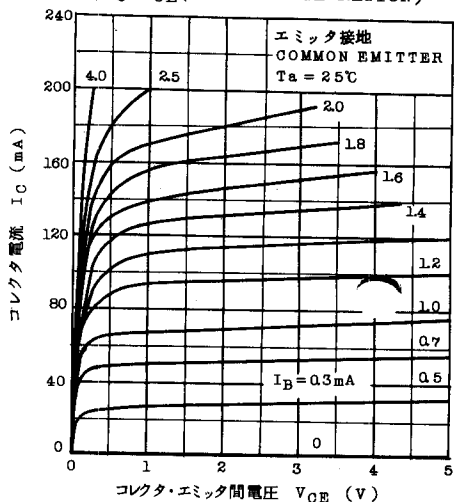
According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SC1166 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC1166-R	40	80
2SC1166-O	70	140
2SC1166-Y	120	240
2SC1166-GR	200	400

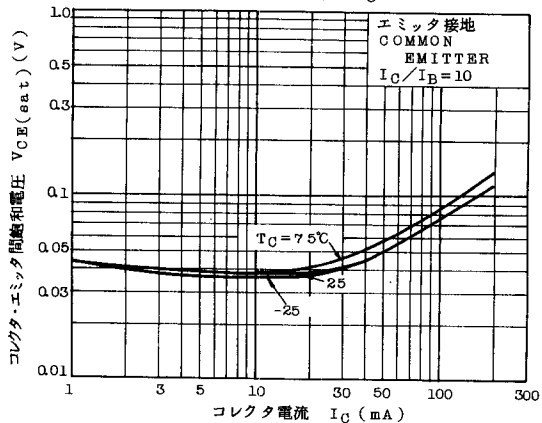
STATIC CHARACTERISTICS



$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)



$V_{CE(sat)} - I_C$



$I_C - V_{BE}$

